

关于举办半导体照明外延、芯片关键技术培训的通知

各有关单位：

半导体照明作为新型的节能环保技术，其核心器件产品 LED 芯片的效率指标以及成本偏高一直是制约我国该产业发展的重要因素。发光效率的提高取决于 LED 外延芯片技术的发展与进步，制造成本的降低则取决于 LED 芯片生产的规模化以及上游配套产业链的技术发展及成本控制能力。为使半导体照明外延、芯片企业技术骨干人员掌握外延、芯片关键技术，同时与行业内其他企业、高校、科研院所技术人员、专家进行交流、研讨。国家半导体照明工程研发及产业联盟将于 2014 年 7 月 13-14 日在广州举办《半导体照明外延、芯片关键技术》培训。

现将 2014 年 7 月 13-14 日《半导体照明外延、芯片关键技术》培训事项通知如下：

一、 培训课程内容

（一）、宽禁带半导体材料 MOCVD 异质外延基础

1. 衬底问题
2. 热力学分析
3. 缺陷与背景载流子浓度

（二）、LED 芯片设计原理及制造技术

4. LED 芯片设计原理
5. 不同结构（正装、倒装、垂直）
6. 芯片制造技术
7. 倒装结构发展历史趋势和困难点

二、主讲专家老师

北京大学宽禁带半导体研究中心 张国义 教授

清华大学电子系 罗毅 教授

三、适用对象

LED 外延芯片企业研发经理及以上职位的相关人员

四、培训费用

培训费：1200 元/人(含培训费、餐费、资料费等)

联盟成员免费。

五、培训收益

1. 掌握 LED 外延材料、MOCVD 生长技术及外延结构优化;
2. 掌握 LED 芯片设计原理、芯片制造技术及倒装结构发展历史趋势和困难点;
3. 与行业内其他企业、高校、科研院所技术人员、专家进行交流、研讨。

六、时间与地点

时间：2014 年 7 月 13 -14 日

地点：广州

七、报名联系

联系人：刘老师

电 话：010-82385580

手 机：18610961064

邮 箱：liukt@china-led.net

国家半导体照明工程研发及产业联盟

2014 年 06 月 24 日